

	<h2 style="color: red;">SI6463BDQ-T1-GE3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SI6463BDQ-T1-GE3</a></p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Vishay / Siliconix</a></p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 20V 6.2A 8-TSSOP</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI6463BDQ-T1-GE3.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 2661 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	


### Spezifikationen

Teilenummer	SI6463BDQ-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 6.2A 8-TSSOP
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	2661 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	800mV @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-TSSOP
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	15 mOhm @ 7.4A, 4.5V
Verlustleistung (max)	1.05W (Ta)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	60nC @ 5V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6.2A (Ta)

SI6463BDQ-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI6463BDQ-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI6463BDQ-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI6463BDQ-T1-GE3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SI6463ADQ-T1</b> SIL SI6463ADQ-T1 SIL</p>	 <p><b>SI6459DQ.</b> VIS SI6459DQ. VIS</p>	 <p><b>SI6463BDQ-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 6.2A 8-TSSOP</p>	 <p><b>SI6463DQ-T1</b> SIL SI6463DQ-T1 SIL</p>
 <p><b>SI6463BDQ</b> V SI6463BDQ V</p>	 <p><b>SI6463BDQ.</b> VIS SI6463BDQ. VIS</p>	 <p><b>SI6463DQ-T1-E3</b> VISHAY SI6463DQ-T1-E3 VISHAY</p>	 <p><b>SI6463BDQ-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 6.2A 8-TSSOP</p>

### SI6463BDQ-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

#### Schlüsselwort

<a href="#">SI6463BDQ-T1-GE3</a>	<a href="#">Vishay / Siliconix</a>	<a href="#">SI6463BDQ-T1-GE3 Datenblatt</a>	<a href="#">SI6463BDQ-T1-GE3-Datenblätter</a>	<a href="#">SI6463BDQ-T1-GE3 PDF</a>	<a href="#">Vishay / Siliconix SI6463BDQ-T1-GE3</a>
<a href="#">SI6463BDQ-T1-GE3 Electronic</a>	<a href="#">SI6463BDQ-T1-GE3-Komponenten</a>	<a href="#">SI6463BDQ-T1-GE3-Verteiler</a>	<a href="#">SI6463BDQ-T1-GE3-Bild</a>	<a href="#">SI6463BDQ-T1-GE3-Bild</a>	<a href="#">SI6463BDQ-T1-GE3-Teil</a>
<a href="#">SI6463BDQ-T1-GE3 Preis</a>	<a href="#">SI6463BDQ-T1-GE3 Hersteller</a>	<a href="#">SI6463BDQ-T1-GE3 Bild</a>	<a href="#">SI6463BDQ-T1-GE3 Aktie</a>	<a href="#">SI6463BDQ-T1-GE3 Inventar</a>	<a href="#">SI6463BDQ-T1-GE3 Inventar</a>
<a href="#">SI6463BDQ-T1-GE3 Neu</a>	<a href="#">SI6463BDQ-T1-GE3 Original</a>	<a href="#">SI6463BDQ-T1-GE3 garantiert</a>	<a href="#">SI6463BDQ-T1-GE3 RFQ</a>	<a href="#">SI6463BDQ-T1-GE3 Online bestellen</a>	<a href="#">SI6463BDQ-T1-GE3 Online bestellen</a>

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited